

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Наименование	Структура	Макс. напр. сток-исток, В	Макс. ток сток-исток макс, А	Макс. напр. затвор-исток, В	Сопрот. канала в откр. сост., МОм	Макс. рассеив. мощность, Вт	Крутизна харак-ки, мА/В	Тип корпуса
КП 959 Б	N-FET	250	0.2	-	57	-	40	КТ-272
КП 959 В	N-FET	200	0.2	-	57	-	40	КТ-272
КП 960 А	P-FET	220	200	-	57	-	-	-
КП 960 Б	P-FET	200	200	-	57	-	-	-
КП 960 В	P-FET	120	200	-	57	-	-	-
КП 961 А	N-FET	120	5	-	0.16	-	-	-
КП 961 Б	N-FET	80	5	-	0.13	-	-	-
КП 961 В	N-FET	60	5	-	0.11	-	-	-
КП 961 Г	N-FET	40	5	-	0.10	-	-	-
КП 961 Д	N-FET	20	5	-	0.10	-	-	-
КП 961 Е	N-FET	10	5	-	0.8	-	-	-
КП 964 В	N-FET	60	20	-	0.025	-	-	-
КП 964 Г	N-FET	20	20	-	0.025	-	-	-
КП 965 Б	N-FET	100	20	-	0.6	-	-	-
КП 965 Г	N-FET	60	5	-	0.4	-	-	-
КП 965 Д	N-FET	20	5	-	0.4	-	-	-
КП 973 А	N-FET	700	30	-	0.03	-	-	-



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ CoolMOS

CoolMOS полевые транзисторы **Infineon** – это новое поколение высоковольтных силовых транзисторов со сверхнизким сопротивлением в открытом состоянии ($R_{ds(on)}$), в 5-10 раз превосходящем параметры стандартных МОП-транзисторов. Транзисторы представлены тремя поколениями: S5 – транзисторы с малым $R_{ds(on)}$, C2 – поколение транзисторов с минимальным временем переключения, C3 – транзисторы с расширенной областью безопасной работы, позволяющие выдерживать импульсные токи с высокими амплитудами.

Области применения: импульсные источники питания в компьютерном оборудовании и бытовой технике, UPS, устройства коррекции коэффициента мощности, сварочное оборудование, системы электропитания.

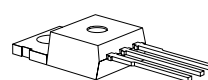
Наименование	Напряжение сток-исток, В	Сопротивление в откр. состоянии, Ом	Максимальный ток стока, А	Тип корпуса	Поколение
SPP02N60	600	3.0	2	TO-220	S5/C3
SPP03N60	600	1.4	3	TO-220	S5/C3
SPP04N60	600	0.95	4	TO-220	S5/C2/C3
SPP07N60	600	0.6	7	TO-220	S5/C2/C3
SPP11N60	600	0.38	11	TO-220	S5/C2/C3
SPP20N60	600	0.19	20	TO-220	S5/C2/C3
SPW11N60	600	0.38	11	TO-247	S5/C2/C3
SPW20N60	600	0.19	20	TO-247	S5/C2/C3
SPW47N60	600	0.07	47	TO-247	S5/C2/C3
SPP02N80	800	2.7	2	TO-220	C3
SPP04N80	800	1.3	4	TO-220	C3
SPP06N80	800	0.9	6	TO-220	C2/C3
SPP08N80	800	0.65	8	TO-220	C3
SPP11N80	800	0.45	11	TO-220	C3
SPP17N80	800	0.29	17	TO-220	C2/C3
SPW11N80	800	0.45	11	TO-247	C3
SPW17N80	800	0.29	17	TO-247	C2/C3

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

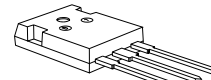
SP	P	11	N	60	C2
1	2	3	4	5	6

1. Полевой CoolMOS транзистор Infineon
2. Тип корпуса
P - TO-220
W - TO-247
A - TO-220 (FullPAK)
B - TO-220 SMD (D2PAK)
D - TO-252 (D-PAK)
I - I2PAK
U - TO-251 (I-PAK)
N - SOT-223
3. Максимальный пост. ток стока (прибл.), А
4. Тип транзистора
N - n-канальный
P - p-канальный
5. Максимальное напряжение сток-исток (x10), В
6. Поколение транзисторов
S5 - 1-е поколение
C2 - 2-е поколение
C3 - 3-е поколение

ТИПЫ КОРПУСОВ



TO-220



TO-247



ТРАНЗИСТОРНЫЕ MOSFET МОДУЛИ

Силовые полевые транзисторы **Mitsubishi Electric** выполнены по Trench-технологии 0.35 мкм и предназначены для управления электродвигателями грузоподъемных средств и электропогрузчиков. Транзисторы имеют малое сопротивление в открытом состоянии, малые потери, защищены от перегрева, не требуют снабберных цепей и отличаются высокой надежностью и эффективностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Номинальный ток, А	Напряжение, В	Сопрот. в откр. состоянии, МОм
FM200TU-07A	100	75	1.2
FM200TU-2A		100	0.8
FM200TU-3A		150	0.53
FM400TU-07A	200	75	2.4
FM400TU-2A		100	1.45
FM400TU-3A		150	0.8
FM600TU-07A	300	75	4.8
FM600TU-2A		100	2.6
FM600TU-3A		150	1.6

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

